

UDC 669.782-41 : 620.173.26
H 23



中华人民共和国国家标准

GB/T 15615—1995

硅片抗弯强度测试方法

Test method for measuring
flexure strength of silicon slices

1995-07-12发布

1996-02-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

硅片抗弯强度测试方法

GB/T 15615—1995

Test method for measuring flexure strength of silicon slices

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硅单晶切割片、研磨片和抛光片(简称硅片)的抗弯强度测试方法。

本标准适用于晶向为 $<111>$ 和 $<100>$ 的直拉、悬浮区熔硅单晶片的常温下抗弯强度的测量。硅片厚度为 $250\sim 900\text{ }\mu\text{m}$ 。

2 引用标准

GB 12964 硅单晶抛光片

GB 12965 硅单晶切割片和研磨片

3 术语

3.1 抗弯强度 flexure strength

试样破碎时的最大弯曲应力,对脆性材料通常是凸表面最大径向张应力,表征抗破碎的性能。

3.2 小挠度 little deflection

圆片受到中心载荷弯曲时,圆片中心面弯曲前后的最大位移与圆片厚度比为小量。

4 方法原理

本标准采用简支圆片集中载荷冲击法测定硅片抗弯强度。

用一钢球从 $1/4$ 圆形轨道上滚下，冲击轨道末端垂直放置的硅圆片试样，不断升高钢球高度直到打碎硅片为止。根据由薄板理论及弹性力学理论推导出的公式(1)计算试样抗弯强度 σ_c ：

式中： σ_c —硅片抗弯强度测试值， N/mm^2 ；

P —钢球质量, kg;

A—试样简支半径, mm;

B—试样厚度, mm;

H——打破试样时钢球下滚垂直高度, mm;

X ($\text{kg} \cdot \text{mm}^{-2}$) $^{1/2}$ 、 Y 、 Z :与硅材料弹性模量和泊松比有关的系数,对<111>硅单晶片,分别为 182, 0.621 及 1.146;对<100>硅单晶片,分别为 207, 0.621 及 1.146。

公式(1)是在薄板小挠度情况下导出,即要求圆片破碎时的最大挠度与试样厚度比小于1/5,因此,对不符合小挠度条件的测试结果要做出校正。